



**МИНОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ**

**Федеральное государственное  
автономное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Национальный исследовательский  
университет «Московский институт  
электронной техники»**

Шокина пл., д. 1, г. Зеленоград, Москва, 124498  
Тел.: +7(499) 731 44 41 Факс: +7(499) 710 22 33  
E-mail: [netadm@miet.ru](mailto:netadm@miet.ru) <http://www.miet.ru>  
ОГРН 1027739615584

23.10.2023 № 96-НОСР/4-8  
на № \_\_\_\_\_

634050, г. Томск, пр. Ленина, 40,  
Томский государственный университет  
систем управления и радиоэлектроники.  
Председателю диссертационного совета  
24.2.415.03 на базе Томского  
государственного университета систем  
управления и радиоэлектроники, д.ф.-м.н.,  
профессору Шандарову С.М.

Уважаемый Станислав Михайлович!

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» подтверждает согласие выступить ведущей организацией по диссертационной работе Томашевича Александра Александровича «Процессы дефектообразования в гетероструктуре GaN-светодиодов с множественными квантовыми ямами» по специальности 1.3.5 – «Физическая электроника» на соискание ученой степени кандидата технических наук.

Необходимые сведения прилагаются.

Приложение: сведения о ведущей организации на 2 стр. в 1 экз.

Проректор по научной работе НИУ МИЭТ,  
д.т.н., профессор

Гаврилов С.А.

008446

**Сведения о ведущей организации**  
по диссертационной работе Томашевича Александра Александровича  
на тему «Процессы дефектообразования в гетероструктуре GaN-  
светодиодов с множественными квантовыми ямами» на соискание ученой  
степени кандидата технических наук по специальности  
1.3.5 – «Физическая электроника»

|  |  |
|--|--|
| Полное наименование организации в соответствии с уставом   | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»  |
| Сокращенное наименование организации в соответствии с Уставом  | Национальный исследовательский университет «МИЭТ», НИУ МИЭТ, МИЭТ  |
| Почтовый индекс, адрес организации   | 124498, Москва, г. Зеленоград, площадь Шокина, д. 1  |
| Веб-сайт   | <a href="http://www.miet.ru">www.miet.ru</a>   |
| Телефон  | +7 (499) 731-44-41   |
| Адрес электронной почты  | <a href="mailto:netadm@miee.ru">netadm@miee.ru</a>   |
| Список основных публикаций работников структурного подразделения, в котором будет готовиться отзыв, по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций) | <p>1) Оптимизация процесса температурной обработки омических контактов Ti/Al/Ni/Au к наногетероструктурам на основе нитрида галлия / В. Егоркин, В. Земляков, А. Неженцев, В. Гармаш // Компоненты и технологии. – 2022. – № 8(253). – С. 90-92.</p> <p>2) Исследование влияния легирования буферного слоя GaN углеродом и железом на эффект вытеснения носителей заряда из буфера в область канала нормально открытых НЕМТ AlGaN/AlN/GaN-транзисторов / П.Ч. Тхан, В.И. Егоркин, В.И. Корнеев, М.Т. Мьо // Научно-технические ведомости СПбГПУ. – 2021. – Т. 22, № 2. – С. 5-15.</p> <p>3) Ковалев, А. А. Базовая технология изготовления СВЧ-и силовой электроники на основе GaN(Si) / А.А. Ковалев, В.И. Егоркин //</p> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>Наноиндустрия. – 2021. – Т. 14, № S7(107). – С. 406-407.</p> <p>4) Нормально-закрытый транзистор с затвором р-типа на основе гетероструктур AlGaIn/GaN / В.И. Егоркин, В.А. Беспалов, А.А. Зайцев [и др.] // Известия высших учебных заведений. Электроника. – 2020. – Т. 25, № 5. – С. 391-401.</p> <p>5) GaN/AlGaIn гетероструктурный транзистор нормальнозакрытого типа с р-затвором для высоковольтных приборов / В.И. Егоркин, А.А. Зайцев, В.Е. Земляков [и др.] // Наноиндустрия. – 2020. – № S96-1. – С. 133-136.</p> |
|--|--|

Проректор по научной работе НИУ МИЭТ,  
д.т.н., профессор



Гаврилов С.А.

«20» октября 2023 г.

